



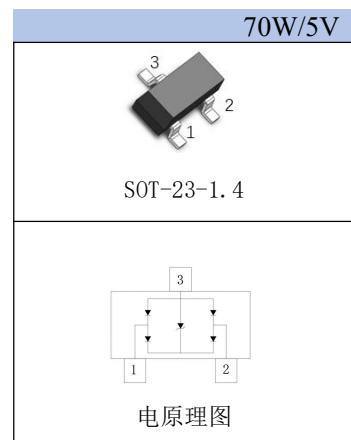
ZL4D25S4P 型瞬态电压抑制二极管阵列

1 特性

- 芯片采用外延平面结构；
- 低电容，响应时间快，双通道；
- 重量 (mg): 9.4±1；
- 潮湿敏感度等级：3 级。

2 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611、Q/RBJ1016QZ	G+: Q/RBJ1016QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级: Q/RBJ-GL-02JS-01A	



3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	P_{PPM} $t_p=8/20 \mu\text{s}$ W	I_{PP} $t_p=8/20 \mu\text{s}$ A	V_{RWM} V	T_{OP} °C	T_j °C	T_{stg} °C
ZL4D25S4P	70	4.0	5.0	-55~125	-55~150	-55~150

4 主要电特性

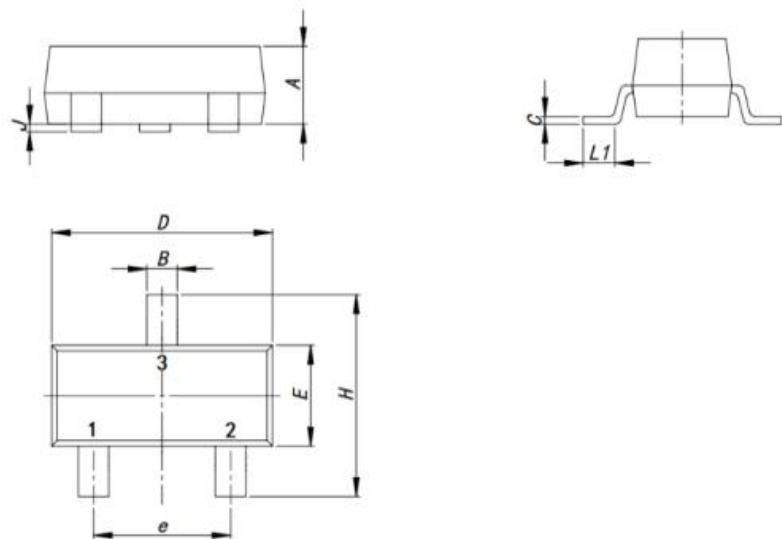
主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数符号	测试条件	数值		单位
			最小值	最大值	
1	V_{BR}	引脚 1、2 分别对 3, $I_R=1\text{mA}$	7.0	8.5	V
2	V_F	引脚 3 分别对 1、2, $I_F=1\text{mA}$	0.5	1.0	V
3	V_{C1}	$I_{PP}=1.0\text{A}, t_p=8/20 \mu\text{s}$	—	15	V
4	V_{C2}	$I_{PP}=4.0\text{A}, t_p=8/20 \mu\text{s}$	—	23	V
5	I_R	$V_R=5.0\text{V}$	—	0.5	μA
6	C_j	$V_R=0, f=1\text{MHz}$ 1脚或2脚到3脚	—	1.0	pF
7	C_j	$V_R=0, f=1\text{MHz}$ 1脚到2脚之间	—	0.5	pF



5 外观尺寸



单位:mm

符号 尺寸	A	B	C	D	E	e	J	H	L1
最小值	0.79	0.30	0.05	2.70	1.07	1.70	-	2.22	0.16
最大值	1.19	0.50	0.25	3.10	1.47	2.10	0.184	2.62	0.36

图1 SOT-23-1.4 外形尺寸